



■ ■ 主要用途：通用运用程序 、开关等。

Applications: .General purpose application, Switching application

■ ■ 特性

Features

特性参数 CHARACTERISTIC	符号 SYMBOL	额定值 RATING	单位 UNIT
集电极-基极电压 Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	-40	V
集电极-发射极电压 Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	-25	V
发射极-基极电压 Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	-6	V
集电极电流 Collector Current	$I_C$	-500	mA
集电极耗散功率 Collector Power Dissipation	$P_C$	300	mW
结温 Junction Temperature	$T_j$	150	°C
储存温度 Storage Temperature	$T_{stg}$	- 55~150	°C



■ ■ 引脚说明

Pin assignment

PIN NAME 管脚符号	PIN NUMBER 引脚序号	FUNCTION 功能
	SOT-23	
B	1	BASE
E	2	EMITTER
C	3	COLLECTOR



■ ■ 电参数

Electrical Characteristics( TC = 25°C unless otherwise noted)

特性参数 CHARACTERISTIC	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITIONS	最小值 MIN.	典型值 TYP.	最大值 MAX.	单位 UNIT
直流电流增益 DC Current Gain	hFE	VCE= -1V, Ic= -5mA	45	170		
直流电流增益 DC Current Gain	hFE	VCE= -1V, Ic= -50mA	85	160	300	
直流电流增益 DC Current Gain	hFE	VCE= -1V, Ic= -500mA	30	80		
集电极-基极截止电流 Collector Cut-off Current	I <sub>CBO</sub>	VCB= -35V, IE=0			-0.1	μA
发射极-基极截止电流 Emitter Cut-off Current	I <sub>EBO</sub>	VEB= -6V, Ic=0			-0.1	μA
集电极-基极击穿电压 Collector-Base Breakdown Voltage	BV <sub>CBO</sub>	Ic= -0.1mA, IE=0	-40			V
集电极-发射极击穿电压 Collector-Emitter Breakdown Voltage	BV <sub>CEO</sub>	Ic= -1mA, IB=0	-25			V
发射极-基极击穿电压 Emitter-Base Breakdown Voltage	BV <sub>EBO</sub>	IE= -0.1mA, Ic=0	-6			V
基极-发射极电压 Base-Emitter Voltage	V <sub>BE(on)</sub>	VCE= -1V, Ic= -10mA		-0.66	-1	V
集电极-发射极饱和压降 Collector-Emitter Saturation Voltage	V <sub>CE(sat)</sub>	Ic= -500mA, IB= -50mA		-0.28	-0.6	V
基极-发射极饱和压降 Base-Emitter Saturation Voltage	V <sub>BE(sat)</sub>	Ic= -500mA, IB= -50mA		-0.98	-1.2	V
电流增益-带宽乘积 Gain bandwidth product	f <sub>T</sub>	Ic= -50mA, VCE= -10V	100	200		MHz
共基极输出电容 Common Base Output Capacitance	Cob	VCB= -10V, IE=0, f=1MHz		15		PF



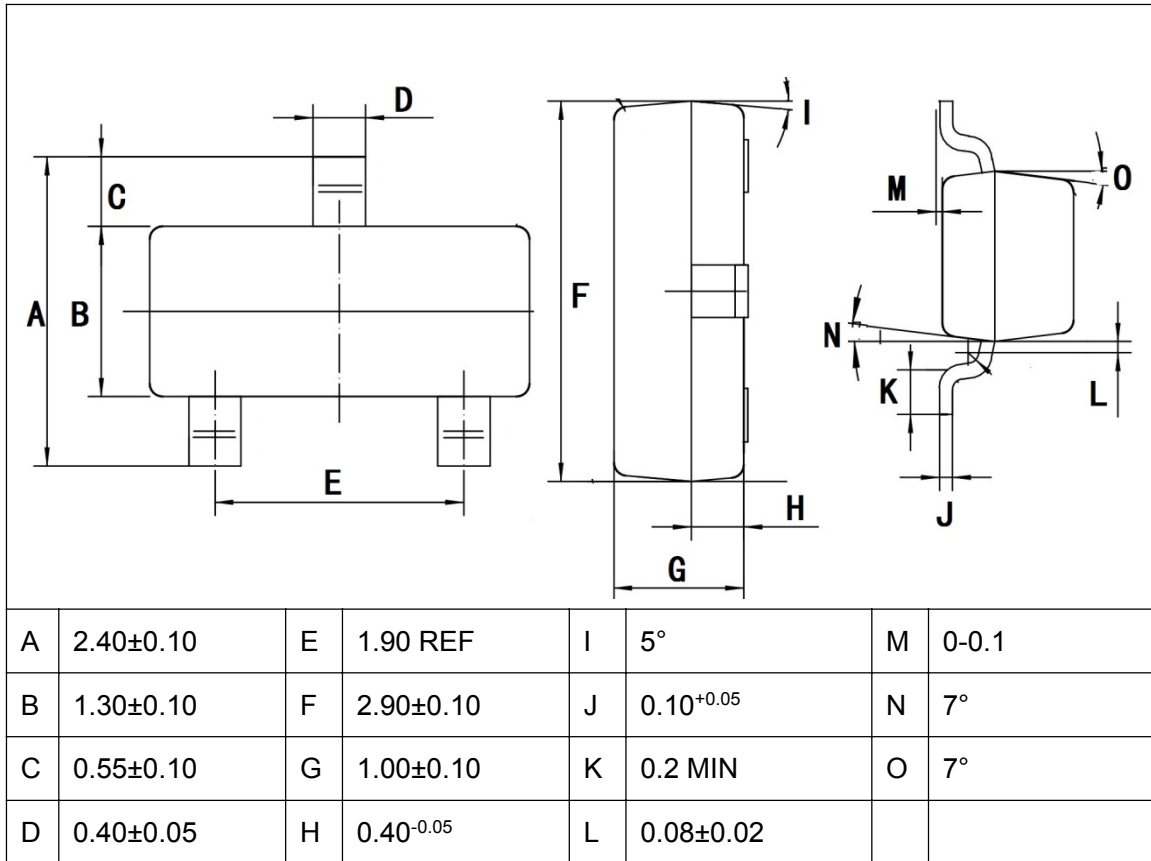
■■ 打标、分档

DEVICE MARKING

打标 Marking	2TY
分档 Value	200~300

■■ 尺寸图

DIMENSION



单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>FH\(风华高科\)](#)